

عنوان مقاله:

بررسی خواص غیر خطی الکتریکی لایه نازک سیلیکان

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی خلاء (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

نرگس صادق بیگی - گروه فیزیک دانشگاه الزهراء(س) ، ونک، تهران

رضا ثابت داریانی

خلاصه مقاله:

اندازه گیری مقاومت ویژه ویفرهای سیلیکان (111) نوع p,n به روش ون در پائو انجام شد. سپس به وسیله تبخیر اشعه الکترونی، یک لایه نازک از سیلیکان بر روی ویفر سیلیکان نشانیدیم. با مقایسه نمودار ویفر سیلیکان با حالت لایه نشانی شده سیلیکان، مشاهده شد برای جریان های کمتر از 2 mA تفاوت آشکاری میان دو حالت وجود دارد که ناشی از لایه نازک سیلیکان می باشد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/57247>

